## X კლასი

- 1. ლითონის ორი ბურთულას ტევადობებია C<sub>1</sub> და C<sub>2</sub>. მათ ცენტრებს შორის მანძილი r გაცილებით მეტია მათ ზომებთან შედარებით. ერთ მათგანს გადასცეს q მუხტი, შემდეგ კი წვრილი გამტარით შეაერთეს მეორესთან. განსაზღვრეთ ამის შემდეგ კულონური ურთიერთქმედების ძალა ბურთულებს შორის.
- 2. ნახაზ 1-ზე მოცემულია ორი ერთნაირი კონდესატორი, რომელთაგან მეორეში მოთავსებულია  $\varepsilon=3$  შეღწევადობის დიელექტრიკი. ეს უკანასკნელი დამუხტეს U მაზვამდე და გამორთეს დენის წყაროდან. რამდენჯერ შეიცვლება კონდენსატორთა სისტემის ენერგია K ჩამრთველის ჩართვის შემდეგ?
- 3. ვოლტმეტრის გაზომვის ზღვარი 500 ვ-ია, მასში გამავალი დენის ძალის მაქსიმალური მნიშვნელობა კი 0.5 ა-ია. როგორ შეიცვლება ვოლტმეტრის გაზომვის ზღვარი, თუ მას დამატებით 2 კ.ომი წინაღობის გამტარს მივუერთებთ?
- 4. განსაზღვრეთ დენის წყაროს ემд და შიგა წინაღობა, თუ წრედში 4 ა დენის გავლისას გარე წრედში სიმძლავრე 48 ვტ-ია, ხოლო 2 ა დენისას კი 32 ვტ.
- 5. დენის წყაროს შიგა წინაღობა გარე წინაღობაზე 9-ჯერ ნაკლებია. რამდენჯერ გაიზრდება დენის ძალა თავდაპირველთან შედარებით დენის წყაროს მოკლე ჩართვისას?
- 6. 200 ვ მაზვაზე გაანგარიშეზული  $P_1=100$  ვტ,  $P_2=200$  ვტ,  $P_3=50$  ვტ, სიმმლავრის ნათურეზი შეაერთეს (ნაზ.2)-ზე მოცემული სქემის მიხედვით და ჩართეს 200 ვ მაზვის ქსელში. იპოვეთ თითოეული ნათურის მიერ მოხმარეზული სიმმლავრე.
- 7. ისარგებლეთ ნახაზ 3-ით და გამოთვალეთ R<sub>AB</sub> , თუ სქემის თითოეული ელემენტის წინაღობაა 3 ომი.
- 8. ნახაზ 4-ზე,  $E_1$ =6 ვ,  $E_2$  =4 ვ,  $E_3$ =2 ვ,  $r_1$ =  $r_2$ =  $r_3$ =1ომი,  $R_1$ =4 ომი,  $R_2$ =2 ომი. იპოვეთ დენის ძალები  $R_1$  და  $R_2$ წინაღობებში.





